

平成 24 年 7 月 9 日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第 145 委員会  
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会  
第 131 回研究会 開催通知

日時： 2012 年 8 月 24 日 (金) 13:00 ～ 17:05  
会場： 明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 (3 階) 第 1・2 会議室  
[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)  
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)  
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分  
東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分  
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「超高耐圧パワーデバイスの現状と将来展望」

－ 新しいエネルギー社会を支えるキーデバイス －

世話人：山本秀和 (千葉工業大学)、土田秀一 (電力中央研究所)、大谷 昇 (関西学院大学)

プログラム

- 13:00～13:05 開会の挨拶 田島道夫
- 13:05～13:10 はじめに 大谷 昇
- 13:10～13:45 「高耐圧パワーデバイス用 Si 単結晶ウェーハの現状」  
吉澤 健 (信越半導体(株) ディスクリートウェーハ事業部)
- 13:45～14:20 「最新 Si パワーデバイスの現状」  
高橋良和、西村芳孝、中澤治雄 (富士電機(株) 電子デバイス研究所)
- 14:20～14:55 「大容量 Si デバイスの電力系統用変換器の適用例」  
江口吉雄 ((株)日立製作所 インフラシステム社 情報制御システム事業部)
- 14:55～15:15 休憩
- 15:15～15:50 「SiC 高耐圧パワーデバイスの現状と応用分野」  
四戸 孝 ((株)東芝 研究開発センター 電子デバイスラボラトリー)
- 15:50～16:25 「超高耐圧 SiC パワー素子実現に向けた厚膜エピ成長と欠陥制御」  
土田秀一、宮澤哲哉、伊藤雅彦、張 璇、田沼良平、鎌田功穂、長野正裕  
(一般財団法人電力中央研究所 材料科学研究所)
- 16:25～17:00 「SiC パワーモジュールの鉄道応用」  
田中 毅、根来秀人、草野健一、山下良範、中嶋幸夫、出井和徳 (三菱電機(株) 伊丹製作所)
- 17:00～17:05 おわりに 山本秀和
- 17:25～19:30 懇親会 (場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)  
以上